

2015年4月23日

高純度臭化水素製造拠点の増強を完了

—半導体メモリの需要拡大に対応—

昭和電工株式会社(社長:市川 秀夫)は、半導体製造工程で使用される高純度臭化水素(HBr)の生産能力を従来比1.5倍の年産600トンに増強し、本年3月より稼働を開始しました。

高純度HBrは、NAND型フラッシュメモリやDRAM等の半導体の製造工程において、ポリシリコンの微細加工(エッチング)に使用される特殊ガスです。近年、半導体メモリは、携帯端末やデータセンター向けを中心に需要が拡大しており、今後も年率10~20%以上の市場成長が期待されています*。

当社は1993年より高純度HBrを製造・販売しており、2008年にはHBrの合成工程を自製化しております。HBrの合成から高純度ガス精製までの一貫生産体制を有する世界唯一のメーカーとして、効率的かつ柔軟な生産体制と高い精製・分析・品質管理技術により、販売量を拡大してまいりました。今回、お客様への安定供給を維持するため、川崎事業所にある製造設備を増強し、年産600トンの生産体制を確立しました。

当社は、現在推進中の中期経営計画「PEGASUS(ペガサス)」フェーズIIにおいて、半導体材料ガスを成長事業に位置づけております。当社は今後も、拡大する世界の半導体市場に迅速に対応し、同事業の強化・拡大を図ってまいります。

以上

*富士経済「2013年 半導体材料市場とアジア戦略」NAND型フラッシュメモリ/DRAMの2015~17年世界市場予測

